

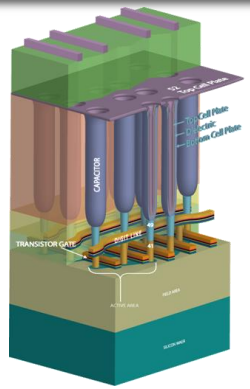
次々世代大容量・広帯域メモリHBM4Eの研究開発

実施者	マイクロメモリ ジャパン株式会社
概要	ポスト5G社会に向けたデータセントリックな高度コンピューティングシステム構築において、 高速・低消費電力・大容量化に対応する広帯域メモリ（HBM）が不可欠 となっている。特に、生成AIの利活用が進むポスト5G社会では、 重要基盤技術の一つとして注目 されている。本事業では、HBM開発の基盤となる先端DRAMの開発を遂行しながら、 並行して先端CMOSデバイスの開発、及びTSV微細化技術の開発 を実行する。これらにより、次々世代のHBM4Eの研究開発を推進し、 世界最高性能のHBM製造技術の開発 を行う。

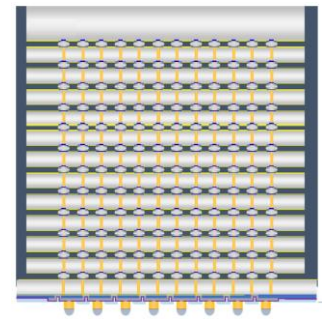
HBM4E

当社HBM3E比

- 容量 : 32Gb (per DRAM die)
- 帯域幅 : x 2倍 2.4TB/s
- パワー : 30%削減
- 積層数 : 12H以上






先端DRAM技術



先端TSV技術
TSV x2倍 | 12H

HBMの高性能化の必要性

-  生成AI
-  ディープラーニング
-  ハイパフォーマンスコンピューティング



- 世界最高性能のHBMを開発し、デジタル化社会の成長に貢献
- ビッグデータ・AIを活用したサイバー空間技術、次世代モビリティの社会実装に向けた取り組みにも貢献